

А. Е. МОЗОЛЬКОВ, В. К. ФЕДЯНИН

ФРАУНГОФЕРОВА ДИФРАКЦИЯ МЕДЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В МОДЕЛИ РЕШЕТОЧНОГО ГАЗА

(Представлено академиком Я. М. Колотыркиным 5 VII 1974)

Обсуждается упругое рассеяние электронов регулярной одномерной и двумерной структурой при наличии адсорбированных частиц. В ряде аспектов данной проблемы определяющую роль играют корреляционные эффекты. Они учитываются в данной работе в рамках модели Изинга. Общие формулы могут быть применены в первую очередь для обсуждения экспериментов по дифракции медленных электронов полимерами и поверхностью металлов, адсорбция на которых моделируется взаимодействием между атомами, занимающими ближайшие соседние узлы структуры.

1. Рассеяние электронов поверхностью твердых тел обсуждается экспериментально и теоретически уже около пятидесяти лет. Однако, если до шестидесятых годов данный процесс изучался не систематически и развиваемая здесь методика являлась скорее дополнением оптических и нейтронографических методик, то в середине шестидесятых годов число экспериментальных работ по различным аспектам проблематики рассеяния электронов твердым телом резко возрастает. Это прекрасно иллюстрируется библиографической подборкой ⁽¹⁾, в которой собраны фактически все работы по рассеянию электронов за 1927—1970 годы. Обусловлено это, конечно, в первую очередь прогрессом в области вакуумной технологии и в методах получения чистой поверхности. Упругое и неупругое рассеяние электронов становится в этой связи ценным методом спектроскопии твердого тела; если же обратиться специально к явлениям адсорбции, то дифракция медленных электронов (д.м.э.) уже позволила установить ряд существенных фактов, касающихся свойств адсорбата. Связано это с тем, что медленные электроны ($E_e \sim 10 - n \cdot 10^2$ эв $n \approx 1 - 5$), обладая длинной волны, сравнимой с постоянными решетки, проникают при этом в глубь твердого тела всего на несколько слоев, что делает их уникальным инструментом изучения поверхностных явлений. Детали дифракционной картины при упругом рассеянии в основном определяются геометрическими факторами (видом элементарной ячейки, упаковкой первых внешних атомных плоскостей), — причем, границы зерен, дефекты приводят к увеличению интенсивности фона, — что и дает основание рассматривать д.м.э. определенным эквивалентом рентгеновской спектроскопии в вопросах определения особенностей поверхностной структуры металлов, окислов и полупроводников. Поскольку $E_e \geq 10$ эв., то влияние колебаний решетки несущественно, хотя их можно учесть обычным образом, добавляя к гамильтониану фононную часть и проводя те или иные аппроксимации при усреднении. Для простоты мы этого делать здесь не будем, полагая, что рассеиватели фиксированы в равновесных положениях. Существеннее учет влияния поверхностных плазмонов, чему посвящено к настоящему времени довольно много работ (см. ⁽²⁾, где даны ссылки). При детальном обсуждении дифракции электронов чистой поверхностью учет вклада плазмонов необходим. Однако в данной работе мы сосредоточим свои усилия на д.м.э. при учете адсорбции, полагая, что ее можно рассматривать в модели решеточного газа с взаимодействием атомов, адсорбированных на ближайших соседних узлах регулярной структуры ⁽³⁾. По этой проблеме, несмотря на ее безу-

ловную значимость, по существу нет теоретических исследований, — единственная публикация (4) касается одномерных систем, что объясняется отсутствием сколько-нибудь удовлетворительной квантово-механической теории адсорбции. Если учесть, однако, вышеупомянутые особенности д.м.э., то можно попытаться обсудить данную проблему в рамках квантостатистической модели адсорбции, предложенной и развитой в (3). Единственный феноменологический параметр в данной модели, константа эффективного взаимодействия атомов, находящихся на ближайших соседних центрах, ϵ ($\epsilon > 0$ притяжение, $\epsilon < 0$ отталкивание), определяемый из экспериментальных данных по теплотам адсорбции, позволяет вполне удовлетворительно описать всю совокупность данных для некоторых систем адсорбат — адсорбент.

2. Амплитуда рассеяния (T -матрица) системы рассеивателей, потенциал которой можно представить как суперпозицию отдельных потенциалов:

$$V(r) = \sum_j v(r - R_j), \quad (1)$$

j — номер узла, R_j — координата j -го рассеивателя, дается выражением (5):

$$T(k', k) = \sum_j t_j + \sum_{j \neq j'} (t_j G_0 t_{j'}) + \dots, \quad G_0 = (\epsilon_k - \epsilon_p + i\delta)^{-1}, \quad (2)$$

$$j_j \equiv t(k', k) \exp(-iqR_j), \quad q = k' - k, \quad \epsilon_p = p^2/2m,$$

— во всех членах суммы (2), начиная со второго, по одному из импульсов функции Грина электрона и одному из импульсов «обкладок» $t_j(k', p)$ и $t_{j'}(p, k)$ выполняется интегрирование (что отмечено скобками):

$$(t_j G_0 t_{j'}) \equiv \int t(k', p) (\epsilon_k - \epsilon_p + i\delta)^{-1} t(p, k) e^{-i(k' - p)R_j - i(p - k)R_{j'}} = \quad (3)$$

$$= \exp(-i[k'R_j - kR_{j'}]) \int t(k', p) G_e(k, p) t(p, k) e^{i\bar{p}(R_j - R_{j'})} d\bar{p}.$$

Амплитуда рассеяния на отдельном рассеивателе $t(\bar{p}', \bar{p})$ дается решением соответствующего «уравнения рассеяния» (6)

$$t(\bar{p}', \bar{p}) = v(\bar{p}', \bar{p}') + \int v(\bar{p}', \bar{p}'') G_0(\bar{p}, \bar{p}'') t(\bar{p}'', \bar{p}) d\bar{p}, \quad (4)$$

т. е. всецело определяется видом Фурье-компоненты потенциала рассеивателя $v(\bar{p}', \bar{p})$. Используемая здесь T -матрица связана с используемой в «фазовом анализе» амплитудой $A(\bar{n}', \bar{n})$, $\bar{n}' = \bar{p}'/p$, $\bar{n} = p/p$ формулой

$$t(\bar{p}', \bar{p}) = -(2\pi)^{-2} m^{-1} A(\bar{n}' \bar{n}) = -\frac{1}{2ipm(2\pi)^2} \sum_l (2l+1) (e^{2i\phi_l} - 1) P_l(\bar{n}, \bar{n}') \quad (5)$$

— мы привели выражение для бесспиновых рассеивателей. При теоретическом обсуждении д.м.э. на чистых поверхностях широко эксплуатируется приближение изотропного рассеяния $\delta_l(p) = \delta(p) \delta_{l0}$. В этом случае

$$t(\bar{p}', \bar{p}) = -(2\pi)^{-2} (2ipm)^{-1} (\exp 2i\delta - 1) = -(2\pi)^{-2} (mp)^{-1} \sin \delta e^{i\delta}. \quad (6)$$

Ряд экспериментальных фактов по д.м.э. при адсорбции удается удовлетворительно объяснить, если воспользоваться результатами, полученными выше и (6). Дифференциальное сечение рассеяния в пренебрежении многократным рассеянием дается выражением

$$\sigma_1(\bar{n}' \bar{n}) = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_1 = \left\langle \sum_{j, j'} t_j t_{j'}^* \right\rangle (2\pi)^4 m^2 \exp[-iq(\bar{R}_j - \bar{R}_{j'})], \quad (7)$$

здесь $\langle \dots \rangle$ означают статистическое усреднение по состоянию, характеризующему «гамильтонианом адсорбции» (см. ниже). В приближении (6) возможно рассмотреть и вклады многократного рассеяния. Так, в частности

учет второго члена в $T(k', \mathbf{k})$ и использование (3), (6) позволяет получить

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) &= \sum_{j, j'} \langle C_j C_{j'}^* \rangle \exp[-iq(\mathbf{R}_j - \mathbf{R}_{j'})] + \sum_{j, j' \neq j''} \langle C_j C_{j'}^* C_{j''}^* \rangle \\ &\cdot \frac{\exp(-ik|R_{j'} - R_{j''}|)}{|R_{j'} - R_{j''}|} \exp(-iq\mathbf{R}_j + ik'R_{j'} - ik\mathbf{R}_j) + \sum_{j', j'' \neq j} \langle C_j C_{j'}^* C_{j''}^* \rangle \\ &\frac{\exp(+ik|R_j - R_{j'}|)}{|R_j - R_{j'}|} \exp(iq\mathbf{R}_{j''} - ik'\mathbf{R}_j + ik\mathbf{R}_j), \end{aligned} \quad (8)$$

вклад новых двух членов может быть проанализирован.

3. Обсудим детально приближение (7). Будем считать, что д.м.э. происходит на регулярной структуре, N_0 узлов которой заняты адатомами, а $(N - N_0)$ узлов обладают свойствами чистой поверхности. В таком случае

$$t_j = \alpha n_j + \beta(1 - n_j), \quad n_j = 0, 1, \quad (9)$$

α, β суть функции k , n вида (5) и являются t -матрицами занятого и свободного узла, соответственно. Гамильтониан адсорбции дается выражением (3)

$$H = -v \sum_j n_j - \frac{\varepsilon}{2} \sum_{j_1 \neq j_2} n_{j_1} n_{j_2}, \quad (10)$$

v есть функция температуры, давления и «внутренних свойств» адатомов (см. (3)), ε — эффективное взаимодействие; суммирование в (10) ведется по узлам решетки в первом слагаемом и по всем парам ближайших соседей во втором слагаемом. Каждый узел имеет z ближайших соседей. Подставляя (9) в (7) и учитывая трансляционную инвариантность, получаем

$$\begin{aligned} \sigma_1(\bar{n}'\bar{n}) &= A \sum_j \exp(-iq\mathbf{R}_j) + B \sum_j \langle n_0 n_j \rangle \exp(-iq\mathbf{R}_j), \\ A &= (2\pi)^4 m^2 N [|\beta|^2 + (\alpha\beta^* + \alpha^*\beta)\Theta], \\ B &= (2\pi)^4 m^2 N [|\alpha|^2 - \alpha^*\beta - \alpha\beta^* + |\beta^2|], \quad \Theta = \langle n_j \rangle. \end{aligned} \quad (11)$$

Первый член, если учесть, что $\sum_j \exp(-iq\mathbf{R}_j) = N\Delta_{\mathbf{q} \parallel \mathbf{g}}$, \mathbf{g} — вектор обратной решетки, \mathbf{g}_{\parallel} — проекция \mathbf{q} на линию и плоскость, соответственно, описывает обычную Фраунгоферову дифракцию; второй член всецело определяется изменением дифракционной картины, обусловленным адсорбцией. Чтобы проанализировать его вклад, необходимо располагать выражением для парного коррелятора $\langle n_0 n_j \rangle$. Сразу же подчеркнем, что пренебрежение корреляционными эффектами ($\langle n_0 n_j \rangle \rightarrow \langle n_0 \rangle \langle n_j \rangle = \theta^2$) автоматически приводит к выводу, что адсорбция не влияет на геометрический вид дифракционной картины, а влияет лишь на интенсивность пятен. Это находится в резком противоречии с экспериментом. Для одномерной системы ($z=2$) использование точных формул для $\langle n_0 n_k \rangle$, $k=0, 1, \dots$ (9), дает

$$\begin{aligned} \sigma_1(\bar{n}'\bar{n}) &= 2\pi(A + Bx_1^2)N^2\Delta_{\mathbf{q} \parallel \mathbf{g}} + BNx_1(1 - x_1) + 2BN[(1 - \lambda)x_1 + \\ &+ \lambda x_2 - x_3] \frac{\cos \Phi}{\lambda} + 2BN(x_3 - x_1^2) \frac{(\cos \Phi - \lambda)}{\lambda(1 - 2\lambda \cos \Phi + \lambda^2)}, \quad \Phi = \mathbf{q}(\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_{k-1}), \end{aligned} \quad (12)$$

x_i , $i=1, 2, 3$, первые корреляторы, формулы для которых приведены в (7), λ функция v, ε, T также приведена в (7). Результат (7) можно использовать в задачах о д.м.э. квазиодномерными системами (полиенами).

Обращаясь к случаю двумерной квадратной решетки удобно ввести $\Phi = \mathbf{q}_{\parallel} \mathbf{j}d$, $\Phi' = \mathbf{q}_{\parallel} \mathbf{j}'d$, где d — постоянная решетки, \mathbf{j}, \mathbf{j}' орты декартовой прямоугольной системы координат, и воспользоваться для $\langle n_0 n_i \rangle$ одной из

аппроксимаций, в которой учитываются корреляционные эффекты (^{1, 8}). В «полиномиальном расщеплении» (^{7, 8}) имеем

$$\sigma_1(\bar{n}'\bar{n}) = 4\pi^2(A+B\Theta^2)N^2\Delta_{\mathbf{q}_{\parallel g}} + BN\Theta(1-\Theta) - 2BN(\Theta^2 - f_2)(\cos\Phi + \cos\Phi'), \quad (13)$$

$$f_2 = \langle n_i n_g \rangle = \frac{1}{4} \sum_0^4 k C_i^k \frac{\Theta^k (1-\Theta)^{z-k}}{1 + \exp(-\beta v - \beta \epsilon k)}.$$

В «суперпозиционном расщеплении» (^{7, 8}) получаем

$$\sigma_1(\bar{n}'\bar{n}) = 4\pi^2(A+B\Theta^2)N^2\Delta_{\mathbf{q}_{\parallel g}} + \frac{(1-\lambda^2)^2}{(1-2\lambda \cos\Phi + \lambda^2)(1-2\lambda \cos\Phi' + \lambda^2)}. \quad (14)$$

При малых покрытиях ($\Theta \ll 1/2$) (13), (14) приводят к результату:

$$\sigma_1(\bar{n}'\bar{n}) \simeq 4\pi^2(A+B\Theta^2)N^2\Delta_{\mathbf{q}_{\parallel g}} + BN\Theta(1-\Theta) - 2BN\Theta^2(1 - e^{\beta\epsilon}) \cdot (\cos\Phi + \cos\Phi'). \quad (15)$$

Для двумерной треугольной решетки ($z=6$) с точностью до Θ^3 выражение для σ_1 можно получить, если воспользоваться результатами (⁸)

$$\sigma_1(\bar{n}'\bar{n}) \simeq 4\pi^2(A+B\Theta^2)N^2\Delta_{\mathbf{q}_{\parallel g}} + BN\Theta(1-\Theta) - 2BN\Theta^2(1 - \exp\beta\epsilon) \cdot [\cos\Phi + \cos\Phi' + \cos(\Phi - \Phi')], \quad (16)$$

где $\Phi = \mathbf{q}_{\parallel} \mathbf{j}d$, $\Phi' = \mathbf{q}_{\parallel} \mathbf{j}'d$, но \mathbf{j} и \mathbf{j}' орты косоугольной системы координат с углом между осями, равным $\pi/3$. Основной особенностью выражений (13) — (16) является наличие дополнительных членов, связанных с адсорбцией и обусловленных корреляционными эффектами. Если первые слагаемые описывают обычные брэгговские максимумы, имеющие в координатах $[(\Phi/2\pi), (\Phi'/2\pi)]$ индексы (m, n) , то при адсорбции возможно возникновение дополнительных пятен с координатами $(m+1/2, n+1/2)$ для (13), (15) и двух дополнительных пятен с координатами $(m+1/3, n+2/3)$, $(m+2/3, n+1/3)$ для (16). Существование подобной дифракционной картины, устойчивой в определенном интервале температур и давлений, хорошо установленный экспериментальный факт (см., например, обзор (⁹), а также (¹)). Полученные здесь формулы позволяют вполне удовлетворительно количественно описать это обстоятельство для целого класса систем адсорбат — адсорбент, сделать выводы о типах структур, возникающих при адсорбции, оценить из д.м.э. параметр ϵ .

Недостаток места не позволяет нам привести здесь результаты расчета вклада двукратного рассеяния в s -приближении. Отметим лишь, что это позволяет объяснить возникновение дополнительных максимумов интенсивности отдельных пятен при изменении энергии падающих электронов («максимумы полупорядка»).

Авторы глубоко благодарны академику Я. М. Колотыркину за обсуждение результатов и ценные замечания.

Физико-химический институт
им. Л. Я. Карпова
Москва

Поступило
5 VII 1974

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Progress in Surface Science, Ed. S. G. Davison, v. 1, 1972. ² C. B. Duke, G. E. Laramore, Phys. Rev. B, v. 3, № 10 (1971). ³ В. К. Федянин, ЖФХ, т. 44, 495 (1970); т. 45, 2867 (1971); т. 46, 119 (1972); Тр. I Всесоюз. конфер. по поверхностным явлениям, ЛГУ, 1972, стр. 27. ⁴ С. Е. Carroll, Surf. Sci., v. 32 (1972). ⁵ Р. Ньютон, Теория рассеяния волн и частиц, М., 1969. ⁶ С. Фудзита, Введение в неравновесную квантовую статистическую механику, М., 1969. ⁷ С. В. Тябликов, В. К. Федянин, Физ. мет. и металловед., т. 23, 2 (1967); В. К. Федянин, В сб.: Статистическая физика и квантовая теория поля, под ред. Н. Н. Боголюбова, «Наука», 1973. ⁸ В. К. Федянин, Международн. конгресс по магнетизму, II, М., 1974, стр. 148. ⁹ P. I. Estrup, E. G. McRae, Surf. Sci., v. 25, 1 (1971).